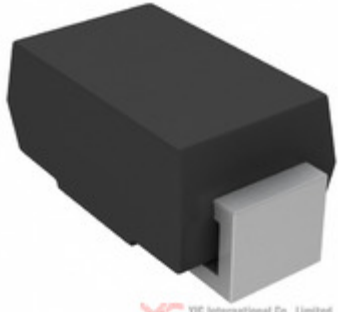
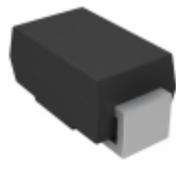
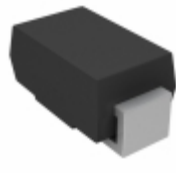

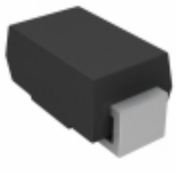
	<h2>US1GHE3/61T</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> US1GHE3/61T</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.US1GHE3/61T.pdf</a> <a href="#">2.US1GHE3/61T.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 130000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	US1GHE3/61T
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	130000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 400V 1A Surface Mount DO-214AC
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 400V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	US1GHE3/61TGICT

US1GHE3/61T ist neu im Original, Suche US1GHE3/61T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie US1GHE3/61T Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage US1GHE3/61T: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>US1GHE3/61T</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1GHE3_A/H</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1GHE3/5AT</b> Electro-Films (EFI) / Vishay Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1GHE3/61</b> VISHAY US1GHE3/61 VISHAY</p>
 <p><b>US1GHE3/5AT</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1GHE3</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1GHE3_A/I</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1GHE3</b> VISHAY</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ US1B-E3/61T	↔ US1B-E3/61T	⇒ US1B-M3/61T	D US1B-M3/61T	⇒ US1BHE3/5AT
⊣ US1BHE3/5AT	⊗ US1BHE3/61T	D US1BHE3/61T	⇒ US1C-E3/61T	⇒ US1D-13-F
⊗ US1D-E3/61T	⊣ US1D-E3/61T	⊗ US1D-M3/61T	↔ US1D-M3/61T	⇒ US1DWF-7
D US1DWF-7	⊗ US1G-13-F	⊣ US1G-E3/61T	⊗ US1G-E3/61T	⇒ US1G-M3/61T
⇒ US1G-M3/61T	↔ US1G/11T	⊗ US1GHE3/5AT	⊣ US1GHE3/5AT	⇒ US1GHE3/61
↔ US1GHE3/61T	⇒ US1GHE3_A/H	D US1GHE3_A/H	⊗ US1GWF-7	⊣ US1GWF-7
⊗ US1J-13-F	D US1J-5AT	⇒ US1J-E3/5AT	↔ US1J-E3/5AT	⇒ US1J-E3/61T
⊣ US1J-E3/61T	⊗ US1J-M3/61T	↔ US1J-M3/61T	⇒ US1J/11T	⇒ US1J/61T
⊗ US1JE-TP	⊣ US1K-13-F	⊗ US1K-E3/61T	D US1K-E3/61T	⇒ US1K-E3D/H
↔ US1K-M3/5AT	⊗ US1K-M3/5AT	⊣ US1K-M3/61T	⊗ US1K-M3/61T	⇒ US1K/11T

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited